

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成17年3月3日(2005.3.3)

【公表番号】特表2004-508720(P2004-508720A)

【公表日】平成16年3月18日(2004.3.18)

【年通号数】公開・登録公報2004-011

【出願番号】特願2002-524235(P2002-524235)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 33/00

【F I】

H 01 L 33/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成15年3月31日(2003.3.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項20】

多数の導電性の領域が、InGaNベースの材料、InNまたはGaNから形成されている、請求項19記載の半導体チップ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項21

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項21】

多数の導電性の領域が、導電性の領域が形成されるように低いAl含有量を有するIn<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>N[式中、0<x<1]またはIn<sub>1-x-y</sub>Al<sub>x</sub>Ga<sub>y</sub>N[式中、0<x<1、0<y<1、x+y<1]から形成されている、請求項20記載の半導体チップ。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項22

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項22】

緩衝層(9)が、多重に、AlGaNベースの多数の個別層から形成されている、請求項19から21までのいずれか1項記載の半導体チップ。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項23

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項23】

薄層素子(11)に隣接する個別層(9)が、薄層素子の層から見て、前記個別層の後に配置された個別層より低いAl含有量を有している、請求項22記載の半導体チップ。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 4】

支持体(5)が、発生する放射線に対して透過性であるかまたは一部透過性である、請求項19から23までのいずれか1項記載の半導体チップ。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 5】

支持体(5)が、発生した放射線を反射する層を有している、または少なくとも部分的に発生した放射線を反射する表面を有している、請求項19から24までのいずれか1項記載の半導体チップ。